

變，故其為  $V_G$  的函數。式 (3.31) 可改寫為：

$$\frac{C}{C_{ox}} = \frac{1}{1 + \frac{\epsilon_{ox} W}{\epsilon_s t_{ox}}} \quad (3.32)$$

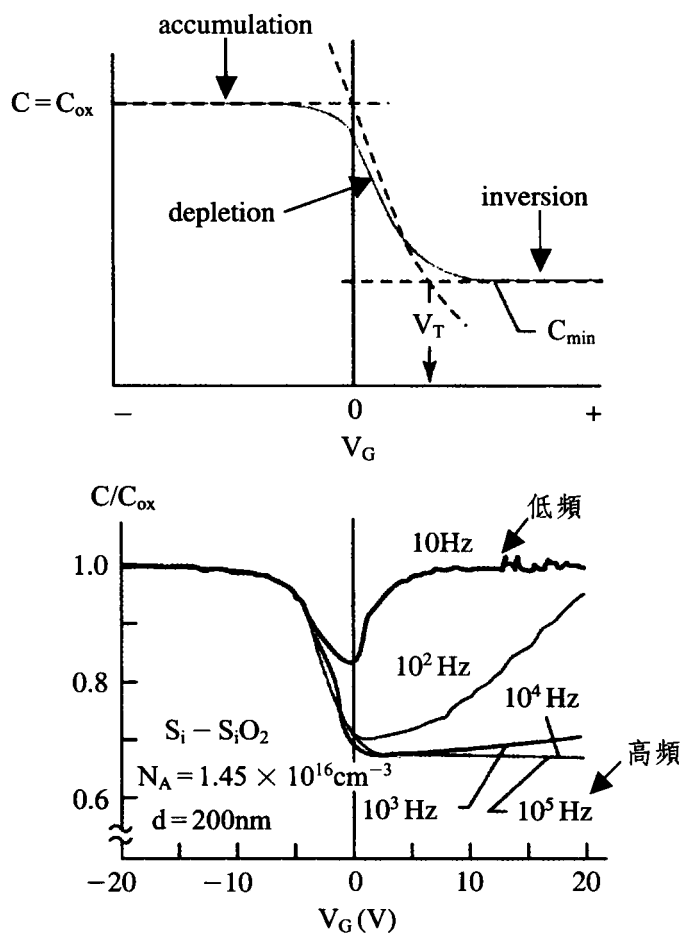


圖 3-7 (a)理想 n-MOS (其矽基板為 p 型) 之高頻 C-V 特性曲線，虛線顯示近似部分 (b)頻率對 C-V 曲線的影響 (取自 Grove[11])。